

## 低待机功耗离线式开关电源IC

### 概述

AP8022芯片内部集成了脉宽调制控制器和全新一代的高可靠性功率MOSFET，适用于小功率离线式开关电源。该芯片提供了完整的智能化保护功能，包括过流保护，过压保护，欠压保护，过温保护。内置抖屏可优化EMI表现，突发模式能够降低系统处于待机模式时的功耗。该芯片还内置高压启动模块和软启动控制电路，保证系统迅速而安全的启动。

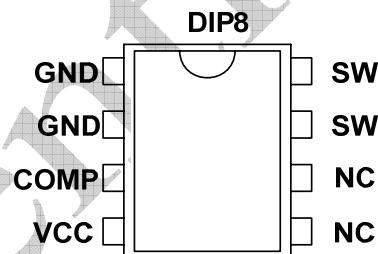
### 特征

- 满足85~265V宽AC输入工作电压
- 单芯片集成700V功率MOSFET
- 内部集成高压启动电路
- 9.5~27V宽电压工作范围
- 60KHz中心工作频率
- 内置抖屏和软启动功能
- 轻载自动调周期功能
- 欠压保护功能
- 保护功能
  - ◆ 过流保护（OCP）
  - ◆ 过温保护（OTP）
  - ◆ 过压保护（OVP）

### 应用领域

- 家电辅助电源
- LED驱动

### 封装/订购信息



订购代码	封装	典型功率
		85~265 V <sub>AC</sub>
AP8022FNEC-T1	DIP8	10W

备注：最大输出功率是在环境温度50° C时具备足够散热片的开放式应用情形下测试。

### 典型应用

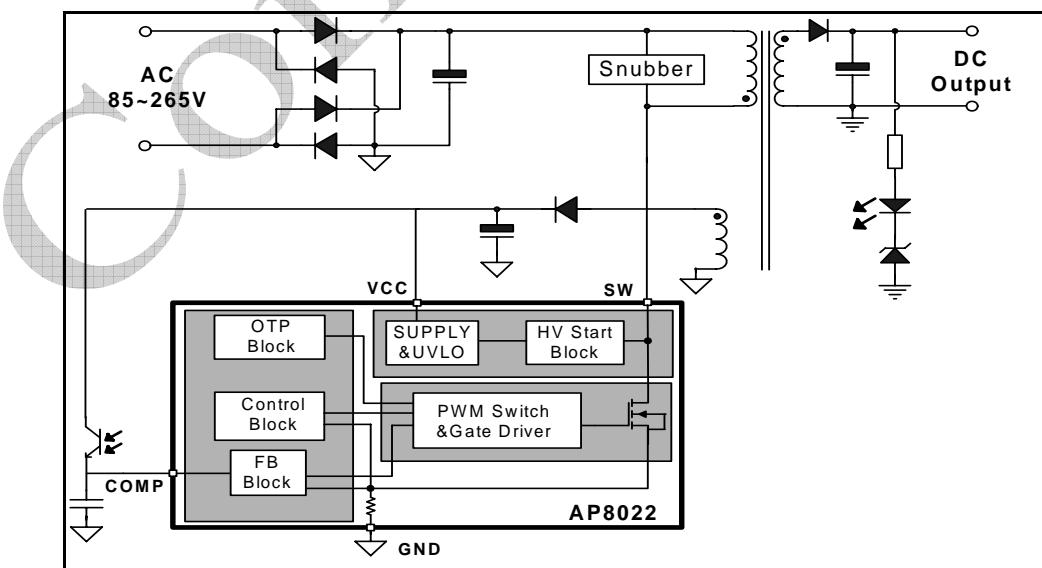


图 1. 应用框图

## 管脚定义

表 1. 管脚定义

管脚标号	管脚名	管脚功能描述
1,2	GND	功率MOS以及控制电路的参考地
3	COMP	反馈输入脚, 用以确定功率MOS的峰值电流
4	VCC	控制电路的供电电源, 启动时由高压启动管对VCC电容进行充电, 当达到UVLO启动电压时, 启动过程结束。
5,6	NC	空脚
7,8	SW	功率MOS的漏极。

备注: NC 脚可接到 SW 引脚

## 典型功率

表 2. 典型功率

产品型号	85~265 V <sub>AC</sub>	230 V <sub>AC</sub> ±15%
AP8022	8W	12W

备注: 最大连续功率在 50 度开放环境且有足够散热条件下测试

## 极限工作范围

VCC 工作电压范围 .....	-0.3~27V
SW 脚最高电压 .....	670V
上电时启动管最高电压.....	670V
反馈脚最大电流.....	3mA
高压功率管电流.....	Internally limited
ESD 能力 (MM) .....	200V
结工作温度.....	Internally limited
工作温度范围.....	-40~150°C
存储温度范围.....	-55~150°C
管脚焊接温度 (10秒) .....	260°C

## 电气特性

( $T_A = 25^\circ\text{C}$ ,  $V_{CC} = 15 \text{ V}$ ; 特殊情况另行说明)

表 3. 热阻部分

符号	参数	DIP7	单位
$R_{THJC\_MAX}$	结与封装壳之间热阻	40	$^\circ\text{C}/\text{W}$
$R_{THJA\_MAX}$	封装与环境之间热阻	80	$^\circ\text{C}/\text{W}$

备注：漏极引脚 PCB 铜超过  $100\text{mm}^2$

表 4. 功率部分

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNIT
$BV_{DSS}$	功率管耐压	$I_D=250\mu\text{A}; V_{COMP}=2\text{V}$	670			$\text{V}$
$I_{DSS}$	功率管关态漏电流	$V_{SW}=500\text{V}; V_{COMP}=2\text{V}$			100	$\mu\text{A}$
$R_{DSON}$	功率管导通电阻	$I_D=0.4\text{A}$		15	17	$\Omega$
$T_r$	上升沿	$I_D=0.1\text{A}; V_{SW}=300\text{V}$		50		$\text{ns}$
$T_f$	下降沿	$I_D=0.2\text{A}; V_{SW}=300\text{V}$		100		
$C_{oss}$	功率管输出电容	$V_{SW}=25\text{V}$		20		$\text{pF}$

表 5. 控制部分

符号	参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
<b>欠压保护部分</b>						
$V_{START}$	欠压保护启动电压	$V_{COMP}=0\text{V}$	13	14.5	16	$\text{V}$
$V_{STOP}$	欠压保护关断电压	$V_{COMP}=0\text{V}$	7.5	8.5	9.5	$\text{V}$
$V_{HYS}$	欠压保护回差			6		$\text{V}$
<b>振荡器部分</b>						
$F_{osc}$	开关频率	$0 \leq T_j \leq 100^\circ\text{C}$	54	60	66	$\text{kHz}$
$\Delta F/\Delta T$	开关频率随温度变化率	$-25^\circ\text{C} \leq T_j \leq +125^\circ\text{C}$		$\pm 2$	$\pm 5$	%
FD	抖频范围			$\pm 5$		$\text{kHz}$
FM	调制频率			125		$\text{Hz}$
DMAX	最大占空比		60	75	90	%
<b>反馈部分</b>						

I <sub>COMP</sub>	COMP关断电流			1		mA
R <sub>COMP</sub>	COMP脚输入阻抗			1.1		kΩ

**限流部分**

I <sub>LIM</sub>	峰值电流	T <sub>j</sub> = 25°C	0.6	0.7	0.8	A
T <sub>ONMIN</sub>	最小导通时间			400		ns
t <sub>SS</sub>	软启动时间			8		ms

**过温保护部分**

T <sub>SD</sub>	过温保护温度		120	160	-	°C
T <sub>HYST</sub>	过温保护回差			40		°C
V <sub>OVP</sub>	VCC过压保护电压		27	30	33	V
Vclamp	VCC电流嵌位电压	V <sub>COMP</sub> =0 I <sub>VCC</sub> >3mA	30	33	36	V

**工作电流部分**

V <sub>SW_START</sub>	漏源启动电压				105	V
I <sub>CH</sub>	启动管充电电流 (SW 脚)	V <sub>DRAIN</sub> = 120 V, V <sub>COMP</sub> = GND, V <sub>CC</sub> = 4 V		-1		mA
I <sub>OPO</sub>	开关态工作电流	V <sub>COMP</sub> = 0V		0.6		mA
I <sub>OP1</sub>	非开开关态工作电流	V <sub>COMP</sub> = 2V		0.3		mA

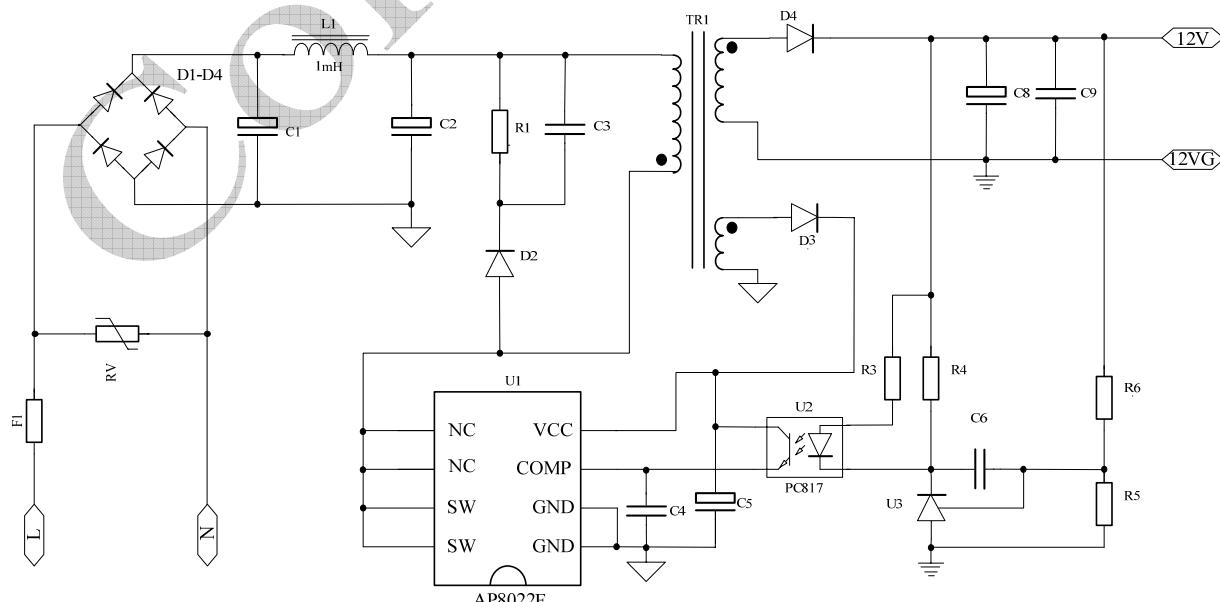
**典型应用**

图 2. 应用典型线路

## 功能描述

### 1. 启动

AP8022 内部集成高压启动电路，启动时 SW 脚对 VCC 电源提供充电电流。当 VCC 电压达到 VSTART 电压时，内部高压启动电路关闭，VCC 电容的能量由变换器提供；一旦 VCC 电压低于欠压保护点，高压启动管开启并为 VCC 电容充电，直至 VCC 电压达到 VSTART。

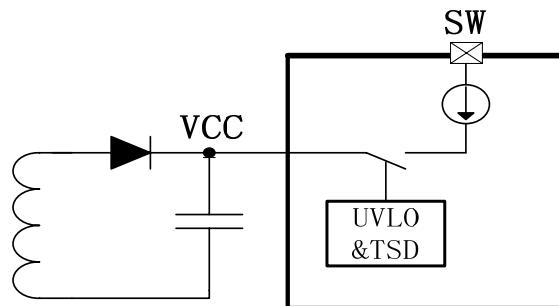


图 9. 启动电路

### 2. 软启动

启动阶段，漏极的最大峰值电流限制逐步的提高；可以大大减小器件的应力，防止变压器饱和。软启动时间典型值为8ms。

### 3. 输出驱动

AP8022采用特有的驱动技术。驱动能力太弱会使得较高的开关损耗，驱动太强则容易出现EMI问题。AP8022采用优化的图腾柱结构，通过合理的输出驱动能力以及死区时间，得到较好的EMI特性和较低的损耗。

### 4. 振荡器

AP8022的振荡频率固定在60 kHz，无需外围电路进行设置。它含有特有的频率抖动技术，可以改善EMI特性。

### 5. 反馈回路

反馈脚通过控制 MOSFET 的开通和关断实现输出的稳定。不同于传统的电压模式 PWM 控制电路，AP8022 采用电流控制方式（如图 10 所示），通过内部采样管得到流过功率 MOS 的电流。从 COMP 脚流入的电流通过 R2 进行采样，采样电压 (VR2) 跟内部基准 VR2 比较；当 VR2 的电压超过内部基准电压时，则关断 MOSFET 实现环路的控制。

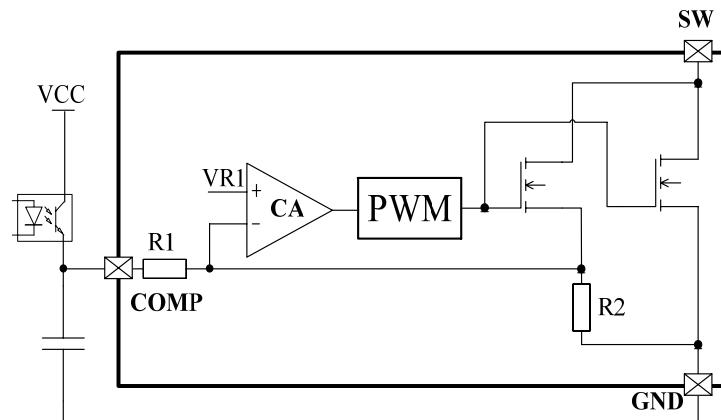


图 10. 反馈电路

## 6. 前沿消隐

由于SW脚的寄生电容，当MOS开通瞬间存在较大的峰值电流，如果采样MOSFET采样到该信号，芯片会进入过流保护状态。为了防止MOS开通瞬间引起电路误触发，过流保护电路在功率管开通一段时间（典型值300ns）后才开始工作。

## 7. 欠压锁定

由于异常情况导致功率管被关闭后，VCC脚电压由于没有提供能量将会一直下降，当VCC电压下降到欠压锁定保护点（典型值9V）时，欠压锁定电路被复位，内部高压电流源重新开始给VCC提供能量。直至VCC电压上升到欠压锁定解除点（典型值13V）时，芯片开始正常工作，功率管正常开启和关闭。通过这种控制方法，芯片在异常情况消除后能自动重启动。

## 8. 过温保护

功率MOSFET和控制芯片集成在一起，能保证温度采样电路更准确的采样功率管的温度信号，从而更及时的对功率管进行保护。当芯片结温超过160°C时（典型值），芯片进入过温保护状态；直至结温回到120°C（典型值）时，芯片重新开始工作。温度保护存在滞回，保证芯片不会出现热振荡现象。

## 封装尺寸

表 6. DIP8 封装尺寸

尺寸 符号	最小(mm)	最大(mm)	尺寸 符号	最小(mm)	最大(mm)
A	9.30	9.50	C2	0.50	
A1	1.524		C3	3.3	
A2	0.39	0.53	C4	1.57TYP	
A3	2.54		D	8.2	8.8
A4	0.66TYP		D1	0.2	0.35
A5	0.99TYP		D2	7.62	7.87
B	6.3	6.5	Ø1	8°TYP	
C	7.2		Ø2	8°TYP	
C1	3.3	3.5	Ø3	5°TYP	

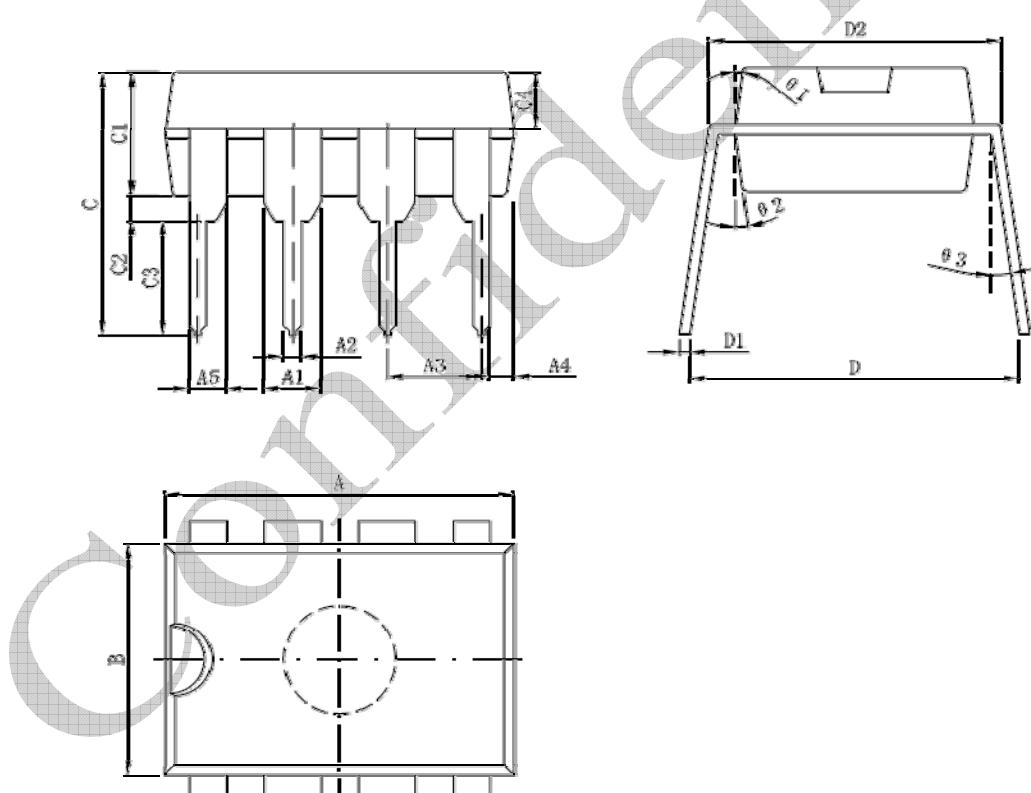


图 11. 外形示意图

表层丝印	封装
AP8022 YWWXXXXX	DIP8

备注: Y: 年份代码; W: 周代码; XXXXX: 内部代码

# X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

***Click to view similar products for [Switching Controllers](#) category:***

***Click to view products by [Chipown](#) manufacturer:***

Other Similar products are found below :

[LV5065VB-TLM-H](#) [LV5066V-TLM-H](#) [LV5725JAZ-AH](#) [633888R](#) [MP2908AGF](#) [AZ7500EP-E1](#) [NCP1012AP133G](#) [NCP1217P133G](#)  
[NCP1218AD65R2G](#) [NCP1234AD100R2G](#) [NCP1244BD065R2G](#) [NCP1336ADR2G](#) [NCP1587GDR2G](#) [NCP6153MNTWG](#)  
[NCP81005MNTWG](#) [NCP81101BMNTXG](#) [NCP81205MNTXG](#) [HV9123NG-G-M934](#) [IR35207MTRPBF](#) [ISL6367HIRZ](#) [CAT874-80ULGT3](#)  
[SJ6522AG](#) [SJE6600](#) [TLE63893GV50XUMA1](#) [IR35215MTRPBF](#) [SG3845DM](#) [NCP1216P133G](#) [NCP1236DD65R2G](#) [NCP1247BD100R2G](#)  
[NCP1250BP65G](#) [NCP4202MNR2G](#) [NCP4204MNTXG](#) [NCP6132AMNR2G](#) [NCP81141MNTXG](#) [NCP81142MNTXG](#) [NCP81172MNTXG](#)  
[NCP81203MNTXG](#) [NCP81206MNTXG](#) [NX2155HCUPTR](#) [UC3845ADM](#) [UBA2051C](#) [IR35201MTRPBF](#) [MAX8778ETJ+](#)  
[MAX17500AAUB+T](#) [MAX17411GTM+T](#) [MAX16933ATIR/V+](#) [NCP1010AP130G](#) [NCP1063AD100R2G](#) [NCP1216AP133G](#)  
[NCP1217AP100G](#)